

Invenția se referă la domeniul electronicii și este destinată dispozitivelor de memorie și de comutare utilizate în tehnica de calcul și de comutare.

Dispozitivul conține o bază din Pb pe care sunt depuse succesiv un strat de absorbție a undelor acustice de suprafață, un strat redresor din ceramică supraconductoare $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$, un strat de dirijare din piezocristal GaAs în centrul căruia este depus un traductor interdigital din Cr-Al, iar între straturile redresor și de dirijare sunt depuse contacte din Cr-Cu. Contactele din Cr-Cu sunt amplasate pe perimetrul unei circumferințe și conțin contacte longitudinale, amplasate de-a lungul axei cristalografice c a compusului $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$, care coincid cu direcția de propagare a undelor acustice de suprafață; contacte transversale, amplasate perpendicular axei cristalografice c a compusului $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$, care sunt perpendiculare direcției de propagare a undelor acustice de suprafață; contacte intermediare, amplasate pe perimetrul circumferinței între contactele longitudinale și cele transversale.